ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

УДК 621.382.2/.3

ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИОДОВ НА ОСНОВЕ П-N-СТРУКТУР, ЛЕГИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОМ В ПРОЦЕССЕ ДИФФУЗИИ.

Али Абдреймов

Жасмина Хожамуратова

[1]Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, ул. Ч.Абдиров №1, 742012 Нукус, Узбекистан, *

Аннотация

В работе представлены экспериментальные результаты по исследованию вольт амперных характеристик p-n перехода лавинных диодах. В местах расположения дислокаций концентрация примесей увеличивается также вследствие повышенного значения коэффициента диффузии вдоль дислокаций. Но увеличение концентрации примеси также приведет к уменьшению $U_{пр}$ в данной локальной области p-n перехода. Следовательно, при подаче обратного смещения на диод в области p-n-перехода с пониженным значением E_g или с повышенной концентрацией примеси начнет развиваться лавинный пробой при напряжении, меньшем $U_{пр}$, для основной части площади p-n перехода. В этой локальной области за счет развития лавины резко возрастет концентрация электронно-дырочной плазмы, поэтому ее иногда называют микроплазмой, а сам пробой – микроплазменным. Участок резкого нарастания тока (от 1/5÷1/3 $U_п$ до $U_п$), где $I \approx U_п$, а n изменяется от 1÷2 до 8÷14 (изменение n с ростом U носит немонотонный характер). Данный участок соответствует эффекту Пула-Френкеля или микроплазменному пробою.

***Ключевые словы**: лавинного пробой, ударной ионизации, дислокаций, запрещенной зона.*

Введение

В современной микроэлектронике, которая построена на основе полупроводников существует глобальная задача: получение импульсных токов за время равное пико- и наносекундам. В Лаборатории функциональной электроники эту задачу решают с помощью фотоэлектрических и электрических переключателей – лавинных S-диодов. Одна из частных задач в данном направлении исследований касается изучения вольтамперных характеристик таких диодов. Лавинный S-диод – это полупроводниковый прибор, на обратной ветви вольтамперной характеристики которого наблюдается участок отрицательного дифференциального сопротивления. Формирование участка отрицательного дифференциального сопротивления происходит при лавинном пробое электронно-дырочного перехода. В результате пробоя происходит перезарядка глубоких центров в n-области, приводящая к увеличению плотности заряда и росту напряженности электрического поля области объемного заряда. Таким образом, появление положительной обратной связи приводит к формированию участка отрицательного дифференциального сопротивления. Объектом данного исследования является лавинный -диод, изготовленный на основе структур, полученных диффузией глубоких примесей в GaAs в открытой системе. Экономическая выгода, связанная с дороговизной кварца, который является расходным материалом при диффузии в закрытой системе. Уменьшение количества технологических операций в процессе производства лавинных -диодов (необходимо только провести отжиг пластины GaAs: Cr)

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

приводит к уменьшению брака, и как следствие к уменьшению себестоимости продукта. С другой стороны, структуры, изготовленные диффузией, в проточной инертно восстановительной системе обладают другим спектром собственных структурных дефектов, вследствие того, что диффузия проводится при пониженном давлении паров летучего компонента – мышьяка. На обратной ветви вольтамперной характеристики π–n-структур, полученных диффузией железа в арсенид галлия n-типа, наблюдается участок с отрицательного дифференциального сопротивления S-типа. Аналогичное явление в области низких температур затем было установлено и для диодных структур, полученных диффузией марганца в GaAs n-типа. Такой же эффект дает компенсация базы диода на основе n-GaAs и другими переходными элементами (например, Cu, Cr). Электрический пробой возникает, если приложенное электрическое поле превышает пороговое поле $U_{обр} > U_{п}$, называемое полем пробоя. В полях над полем пробоя электрический ток резко возрастает. В твердых телах, исходный электрон нагревается полем до тех пор, пока он не достигнет достаточной энергии для создания другого электрона ударной ионизацией. Этот процесс в конечном итоге приводит к «лавине» электронно-дырочных пар [1].

Микроплазменный лавинный пробой

При большом обратном смещении на p-n-переходе, которое создает в нем большое электрическое поле, переход «пробивается» и через него протекает очень большой ток. Существует три основных механизма пробоя: тепловая неустойчивость, туннельный эффект и лавинное умножение. Лавинное умножение, или ударная ионизация, является наиболее важным механизмом пробоя p-n-перехода [2]. Если напряженность поля в области пространственного заряда p-n перехода при подаче обратного смещения превысит некоторое критическое значение $Ɛ_n$, то носители заряда ускоряясь в этом поле, на определенном пути будут набирать энергию $E_n=1,5E_g$, достаточную для ионизации атомов полупроводника за счет соударения. В p-n-переходе начнет развиваться процесс ударной ионизации. При каждом акте **ударной ионизации горячий электрон или дырка** выбивают у атома полупроводника валентный электрон. В результате образуется пара свободных носителей электрон и дырка. Теперь уже три носителя будут принимать участие в ударной ионизации, и в следующем акте ударной ионизации каждый из них породит электронно-дырочную пару**.** Экспериментально установлено, что напряжение переключения при обратном смещении на π–n-структуре примерно совпадает с напряжением лавинного пробоя π–υ– перехода и температурные зависимости $U_{п}$ и $U_{пр}$ одинаковы. Отсюда можно сделать вывод о том, что формирование участка с ОДС S-типа на обратной ветви вольтамперной характеристики таких диодных структур обусловлено развитием лавинного пробоя в π–υ– переходе. Лавинный пробой развивается одновременно по всей площади p-n-перехода только в том случае, если свойства ОПЗ всюду одинаковы. Однако в реальных диодах это условие часто **нарушается**, например, из-за наличия скоплений краевых дислокаций, пересекающих p-n-переход. В диффузионных p-n-переходах такие дислокации могут возникнуть в процессе диффузии примеси из-за несогласованности кристаллической решетки в областях с диффузантом и без него. Вокруг скопления дислокаций возникает область повышенных механических напряжений. Причем независимо от знака констант деформационного потенциала существуют участки ОПЗ, где ширина запрещенной зоны полупроводника уменьшается, так как с дислокацией связаны области как растяжения, так и сжатия. Там, где ширина запрещенной зоны (E_g) уменьшается, снижается энергия, необходимая для образования электронно-дырочной пары за счет акта

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

ударной ионизации, а также $E_{пр}$ и $U_{пр}$. Кроме того, около дислокаций практически всегда имеется примесная атмосфера, что эквивалентно повышению уровня легирования полупроводника в данном месте. В местах расположения дислокаций концентрация примесей увеличивается также вследствие повышенного значения коэффициента диффузии вдоль дислокаций. Но увеличение концентрации примеси также приведет к уменьшению $U_{пр}$ в данной локальной области p-n перехода. Следовательно, при подаче обратного смещения на диод в области p-n-перехода с пониженным значением E_g или с повышенной концентрацией примеси начнет развиваться лавинный пробой при напряжении, меньшем $U_{пр}$, для основной части площади p-n перехода. В этой локальной области за счет развития лавины резко возрастет концентрация электронно-дырочной плазмы, поэтому ее иногда называют микроплазмой, а сам пробой – микроплазменным. На рисунке 1 представлена обратная вольтамперной характеристики p-n-перехода при наличии микроплазм.

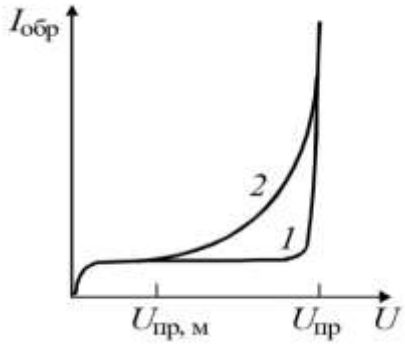


Рисунок 1 – Обратная ветвь вольтамперной характеристики идеального p-n-перехода (1) и при наличии микроплазмы (2) [3]

Перенос заряда при пробое осуществляется через микроплазмы (МП), количество которых экспоненциально растет с приложенным напряжением, либо наблюдается “расползание” МП с ростом напряжения. В работе [4] рассмотрена модель, основанная на том, что токи, переносимые каждой МП, примерно равны и имеет место экспоненциальный рост числа МП с напряжением. Согласно этой модели, вольтамперной характеристики на участке лавинного пробоя можно представить выражением: $I=I_1 \cdot U \cdot \exp(\mu)$, где μ^{-1}= const (U) Uпр. В данном подходе, когда число микроплазм или их диаметр растет со смещением, сопротивление растекания учитывается величиной тока, протекающего через микроплазму, и входит в величину коэффициента в показателе экспоненты μ: $\mu^{-1} = I_{обр} \cdot R_s$ ($I_{обр}$ – обратный ток в области пробоя, R_s – сопротивление растекания). Экспоненциальная зависимость тока от напряжения при микроплазменном пробое p-n–перехода, содержащего глубокие центры, видимо, будет иметь место и за счет изменения R_s в результате инжекции носителей заряда в базу из микроплазмы или пробоя в базе на границе с области объемного заряда. Экспоненциальный рост тока переключения с температурой указывает на то, что начало появления участка отрицательного дифференциального сопротивления можно связать с возрастанием объемного заряда в области объемного заряда вследствие захвата дырок, образованных при лавинном пробое π-ν-перехода, на глубокие отрицательно заряженные центры.

Постановка задачи

Обратная статическая вольтамперной характеристики диодов на основе π-n-структур, легированных Fe в процессе диффузии, состоит из трех участков. Первый описывается генерационно-рекомбинационной теорией Саа-Нойса-Шокли. Второй связан с эффектом Пула-Френкеля. Третий объясняется лавинным микроплазменным пробоем. При

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

исследовании высоковольтных лавинных -диодов ранее не были исследованы статические характеристики диодов, созданных по диффузионной технологии в открытой системе. В связи с этим целью настоящей работы является экспериментальное исследование статической обратной вольтамперной характеристики таких структур.

Методика эксперимента

Для π-n-структуры: 1) π – слой имел концентрацию основных носителей заряда p ~$1{,}011\cdot10^{11}$ $см^{-3}$ и получен диффузией железа $N_{Fe}=1{,}5\cdot10^{17}$ $см^{-3}$; 2) Глубина проникновения железа составляла 25 мкм; 3) Удельное сопротивление π – слоя: $\rho_\pi = 5{,}8\cdot10^5$ Ом·см; 4) Подложка имела концентрацию основных носителей заряда: $N_d=2{,}5\cdot10^{16}$ $см^{-3}$;

Проводились измерения статических вольтамперных характеристик. Измерения вольтамперной характеристики проводились при температуре 350К, в диапазоне напряжений от 0,01В до 0,1кВ и силы тока от 10^{-11}А до 10^{-5}А. Время измерения одной пары значений сила тока – напряжение составляло 0,5минут, что связано с долговременной релаксацией тока в таких структурах. При измерении вольтамперной характеристики на диод сначала подавалось напряжение близкое к напряжению пробоя, после чего напряжение снижалось. На рисунке 2 представлена типичная вольтамперной характеристики S-диода, диффузионной технологии, при температуре 350К.

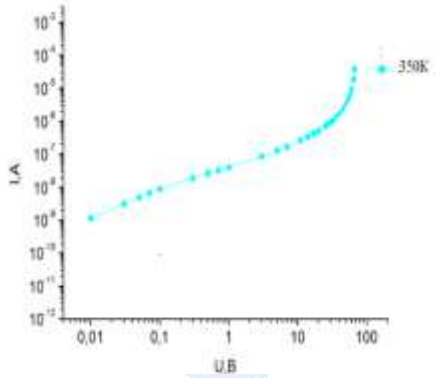


Рисунок 2 – Вольтамперная характеристика лавинного диода, легированного железом, при температуре 350К.

ВАХ можно разбить на 3 участка. 1) 10мВ÷100мВ – линейная зависимость тока от напряжения. 2) 100мВ ÷3 В – сублинейная зависимость тока от напряжения. 3) 3÷80 В – экспоненциальная зависимость J~exp(γ·U).

Рассмотрим третий участок:

На рисунке 3 представлена зависимость тока от напряжения в полулогарифмических координатах, при температуре 350К.

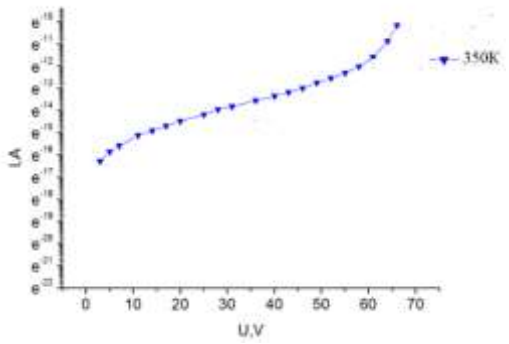


Рисунок 3 – Зависимость силы тока I от напряжения U

При увеличении температуры участок лавинного пробоя сдвигается вправо, потому что напряжение пробоя увеличивается с температурой. Из зависимости рисунка 3 были

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

рассчитаны тангенсы угла наклона и построены их температурные зависимости, которые представлены на рисунке 4.

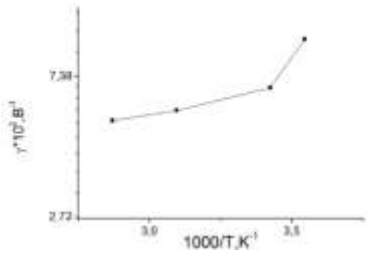


Рисунок 4 – Зависимость тангенса угла наклона от обратной температуры $1/T$

Из зависимости рисунка 3 была рассчитана постоянная γ=0.07 $В^{-1}$, которая совпала со значением γ=0.07 $В^{-1}$, которое было получено в работе [5]. В расчёте брали постоянную Больцмана: $k=8.63\cdot10^{-5}$ эВ/К.

Обсуждение результаты измерения вольтамперных характеристик

Проводилась аппроксимация для трёх температур, потому что при низкой температуре, напряжение лавинного пробоя оказывается достаточно маленьким и участок с экспоненциальной зависимостью выделить не удалось. Совпадение теории с экспериментом говорит о том, что данный участок связан с лавинным микроплазменным пробоем, который описывается формулой [6]:

$$I = I_1 \cdot \exp(\gamma \cdot U), \quad (1)$$

где I_1, γ – постоянные величины.

Из формулы (1) следует, что зависимость, представленная на рисунке 3, должна спрямляться в полулогарифмических координатах, однако это не так. Из литературы известно [5-8], что участок вольтамперной характеристики, на котором с увеличением напряжения уменьшается величина dI/dU, вызван ограничением тока сопротивлением растекания.

Заключение

В представленной работе исследовались вольтамперные характеристики лавинных S-диодов. Которой рассматривались механизмы, влияющие на вид электрических характеристик лавинных -диодов. По окончании исследования были получены следующие результаты: Измерены вольтамперная характеристики лавинных -диодов, структур π-n-типа. Измерения проводились при температуре 350К. Установлено, что вольтамперной характеристики структур π-n-типа третий участка: 3÷80 В – лавинный микроплазменный пробой $J\sim\exp(\gamma\cdot U)$**.** При введении примеси железа в запрещенной зоне GaAs появляются глубокие акцепторные уровни, и роль базы в таком диоде играет перекомпенсированная π-область, удельное сопротивление которой при 350 К порядка 10^4 - 10^5 Ом-см. Наличие локальных мест в π - n -переходе с пониженным значением U_{np} приводит к возникновению микроплазменного пробоя. Вследствие большого сопротивления микроплазмы существует участок вольтамперной характеристики, на котором dl/dU уменьшается по мере роста напряжения

Литературы

1. Hjalmarson H. P., Kambour K., Myles C. W., Joshi R. P. Continuum models for electrical breakdown in photoconductive semiconductor switches / Proc. 16th IEEE Pulsed Power Conf., (IEEE, NY, 2007), Albuquerque, NM, 2007.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261,SJIF 2022-2.889,
2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

3. Гаман, В. И. Физика полупроводниковых приборов / В. И. Гаман. – Томск: Изд. НТЛ, 2000. – 426 с.
2. Зи, С. М. Физика полупроводниковых приборов / С. М. Зи; пер. с англ. под ред. Р. А. Суриса. – М.: Мир, 1984. – 456 с.
4. Грехов И. В., Крюкова Н. Н., Челноков В. Е. Микроплазменные явления в кремнии // ФТТ. – 1966. – Т. 8, № 12. – С. 3474-3479.
5. Прудаев, И.А., Хлудков С.С. Влияние толщины базы лавинного S-диода на его обратную вольтамперную характеристику // Изв. вузов. Физика. – 2011. - № 2. - С. 48-53.
6. Прудаев, И.А., Хлудков С.С., Скакунов М.С., Толбанов О.П. Переключающие лавинные S-диоды на основе GaAs многослойных структур // Приборы и техника эксперимента. – 2010. - № 4. - С. 68-73.
7. Абдреймов А. А., Тагаев М. Б., Статов В. А., Хожамуратова А. Р. Уточненный метод определение параметров микроплазм в промышленных лавинно-пролетных диодах. Вестник ККОАНРУз. Нукус-2021. в 2. с5-9.
8. Tagaev M. B. Influence of external influences on the electrical properties of spatially inhomogeneous diode structures. Doctoral dissertation, Tashkent, 2001